

SMD-N1G48

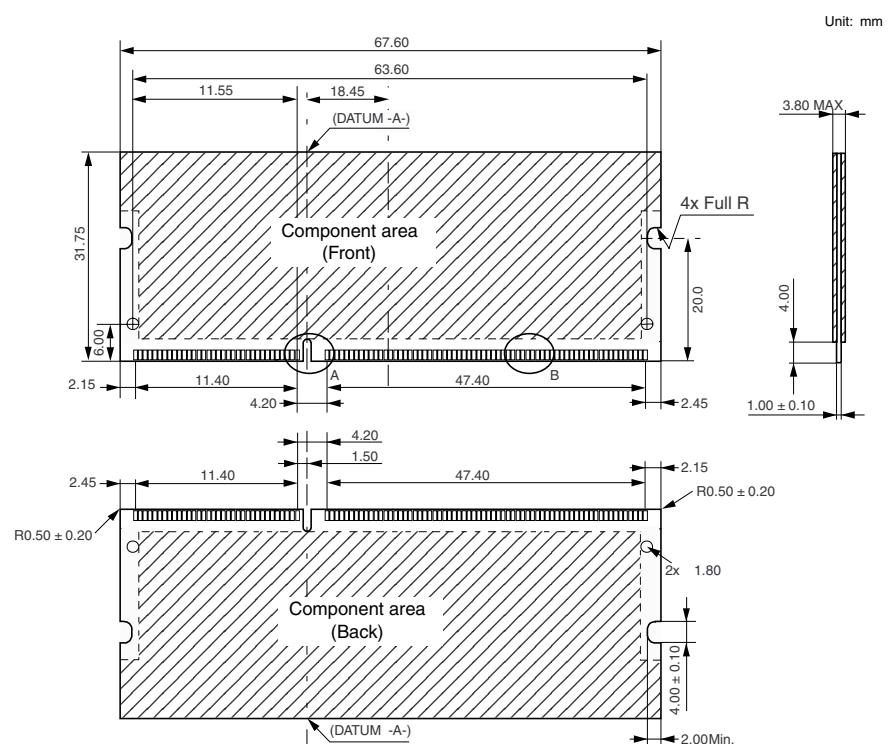
DESCRIPTION

SMD - N1G48は、512MビットDDR・DRAM (64Mx8bit) を16個搭載した128Mx64ビットDDR・DRAMモジュールです。

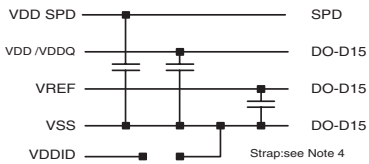
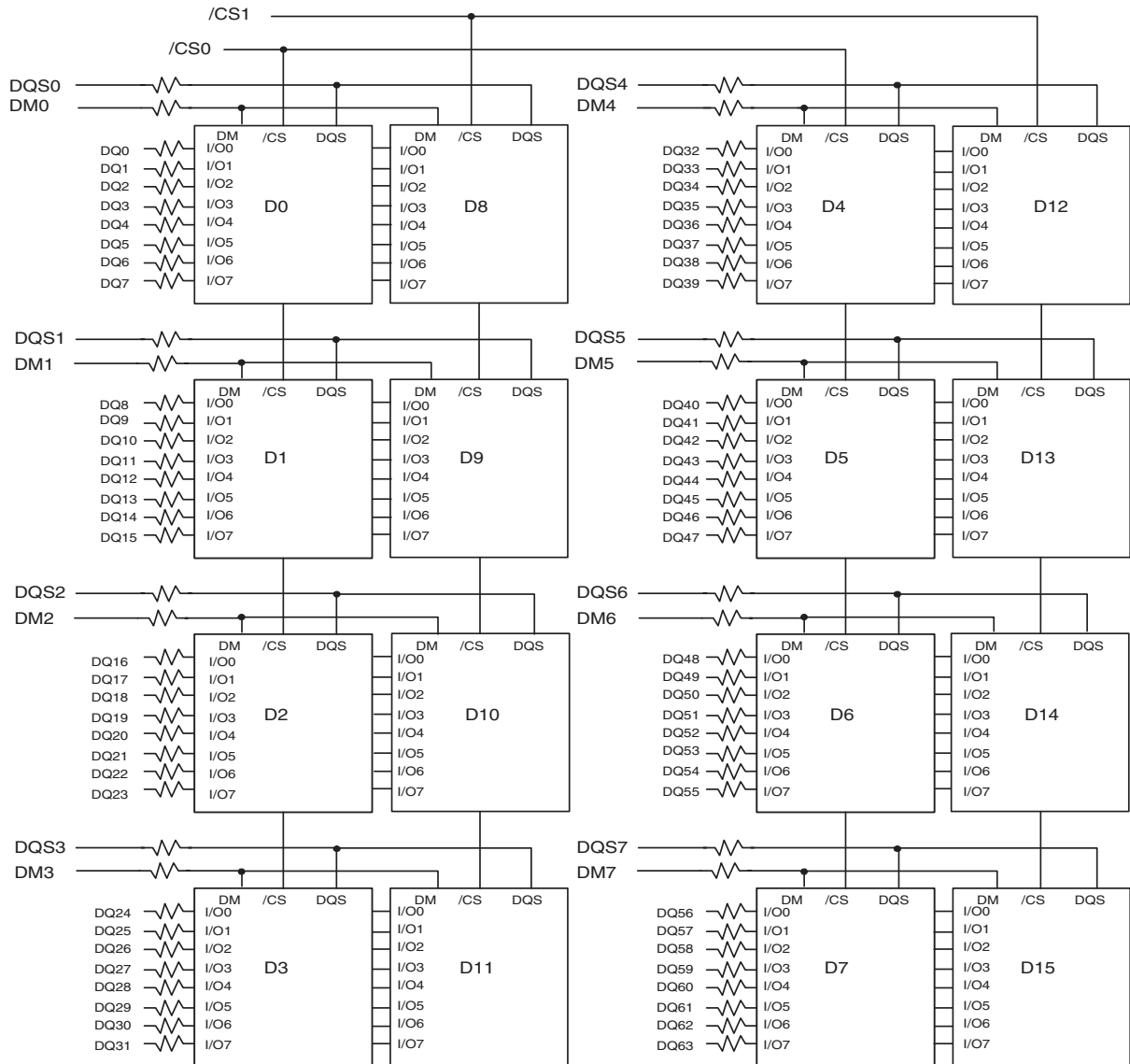
FEATURES

- ・ 200ピン・デュアル・インライン・メモリ・モジュール
(ピン・ピッチ 0.60mm)
- ・ 基板高 1.25" (31.75mm)
- ・ CL - tRCD - tRP=3 - 3 - 3 (PC3200) 2.5 - 3 - 3 (PC2700/PC2100)
- ・ 2.6V±0.1V単一電源 (PC3200) 2.5V±0.2V (PC2700/PC2100)
- ・ 8, 192リフレッシュ/64ms
- ・ SSTL_2コンパチブル
- ・ /CASレイテンシー3.0, 2.5クロックプログラマブル (PC3200)
- ・ " 2.5, 2.0クロックプログラマブル (PC2700/PC2100)
- ・ 2バンク構成
- ・ アンバッファードタイプ
- ・ シリアルPD
- ・ 接続端子: 電解金メッキ (t 0.76µm)
- ・ Pbフリー、RoHS対応品

Outline Drawing

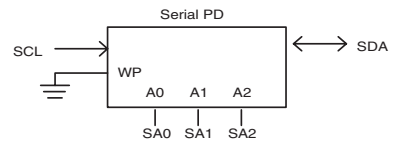


Functional Block Diagram



*Clock Wiring	
Clock Input	SDRAMs
*CK0, /CK0	8 SDRAMs
*CK1, /CK1	8 SDRAMs
*CK2, /CK2	0 SDRAMs

*Wire per Clock Loading Table/Wiring Diagrams



- BA0-BA1 → BA0-BA1 : SDRAMs D0-D15
- A0-A13 → A0-A13 : SDRAMs D0-D15
- CKE1 → CKE : SDRAMs D8-D15
- /RAS → /RAS : SDRAMs D0-D15
- /CAS → /CAS : SDRAMs D0-D15
- CKE0 → CKE : SDRAMs D0-D7
- /WE → /WE : SDRAMs D0-D15

Note :

1. DQ-to-I/O wiring is shown as recommended but may be changed.
2. DQ/DQS/DM/CKE/S relationships must be maintained as shown.
3. DQ, DQS, DM/DQS resistors : 22 Ohms ± 5%.
4. VDDID strap connections
(for memory device VDD, VDDQ):
STRAP OUT (OPEN) : VDD = VDDQ
STRAP IN (VSS) : VDD •V DDQ